20-P28

BEAM MATCHING SECTION FOR ICR LINAC

H.Dewa, H.Fujita, M.Ikegami, M.Inoue, Y.Iwashita, S.Kakigi, M.Kando, A.Noda, H.Okamoto and T.Shirai

> Institute for Chemical Research, Kyoto University Gokanosho, Uji-city, Kyoto-fu 611, Japan

ABSTRACT

The beam matching section between 433 MHz proton RFQ Linac and Alvarez Linac was developed. Six permanent magnetic quadrupole lenses (PMQs) and a double gapped buncher are installed in a 565 mm beam matching section. Each PMQ is consist of eight trapezoidal magnets made of Nd-Fe-B. The beam matching section with the PMQs can be designed under the small space restriction.

化研リニアックのビームマッチングセクション

1. 序

京都大学化学研究所の陽子線形加速器は433 MHzのRFQリニアックとアルバレ型リニアッ クからなる。イオン源からでてきた50keVの 水素イオンをRFQリニアックでRFバンチと2 MeVまでの加速を行ない、565mmのビーム マッチングセクション(BMS)を経てアルバレ で7MeVまで加速する。RFQから出てきたビ ームをそのままアルバレで加速すると横方向のビ ームマッチングがとれないのでRFQとアルバレ の間にBMSを設ける必要がある。

長いBMSを設置するとRFQからアルバレま でビームが進む間にバンチ幅が拡がってしまう。 このためBMSの設計においては横方向の収束の みならず、縦方向の収束も考える必要がある。

このBMSについては初め8個の永久磁石四重 極レンズ¹⁾ (Permanent Magnetic Quadrupole lens; P MQ)とバンチャーによるデザイン²⁾が考えられ たが、5kW程度の電源で200kVの電圧を発 生させるため、バンチャーを大きくする必要があ り、このためビーム光学系を新しく設計すること となった。新しい設計のもとでダブルギャップバ ンチャーを製作した^{3),4)}が、PMQについては前の デザインのもとで製作されたPMQのうちの4個 をビームが発散しないように設置しただけで、ビ ームのマッチングはとれていなかった。

そこでマッチングがとれるように今回新しくP MQを製作した。ビームがPMQに当らないよう にビーム径とPMQの内径の比を大きくすること 及びビーム通過型のパルスビーム電流モニターを 設置することを考慮してBMSのビームオプティ クスの再設計を行なった。以下BMSの設計、P MQの設計および製作について報告する。

2. BMSの設計

ビーム軌道計算のための計算機コードであるT RACE3ーDを使ってBMSの設計計算を行な った。まずビーム径と内径の比を大きくとるため にできるだけビーム径が小さくなるような収束系 とした。また同じ収束力を得る場合でも磁場勾配 を小さくして磁石の長さを長くするようにした。 こうすることでPMQの内径を大きくできる。

またトロイダルコアをつかったビーム非破壊の ビーム電流モニター⁵⁾をアルバレ直前に設置するた めの空きスペースを設けた。30ターンのコイル を巻いたトロイダルコアはトーラス型のガラス管 に封入されている。ガラス管の内径、外径、長さ はそれぞれ12mm、40mm、45mmである。 このモニターとアルバレの後ろのファラデーカッ プによりアルバレのトランスミッションを測定す ることができる。

図1にTRACE3-Dの計算結果を示す。バ ンチャーの前に4個、後ろに2個のPMQを配置 した。最大のビーム半径は5番目のPMQで5.0 mmである。ただしエミッタンスの値はPARM TEQによる粒子数1000個のビームシミュレ ーション計算から得られた100%エミッタンス の値である。



図1 TRACE3-Dの計算結果

3.PMQの設計

BMSにおいては永久磁石でできたPMQを用 いてビームマッチングをおこなっている。PMQ を使うことの利点は小型なものが製作できること、 小型でも強い磁場が得られること、冷却が不要な ことがある。不利な点としては磁場の強さを変え られないこと、高次成分を含むこと等がある。こ のBMSでPMQを使った理由は、小型化の要求 が大きかったためと、計算上はビーム電流が変化 した場合に磁場の強さを変えなくてもビームロス が生じないことが確かめられているためである。 製作したPMQの形状を図2に示す。

8つの台形型磁石からなる構造のもので次式で 表される四重極成分の磁場勾配が発生する。

$$\frac{\partial B}{\partial r} = \frac{8}{\pi} \frac{B_r}{r_1} \left(1 - \frac{r_1}{r_2} \right) \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

ただし B_r は磁石の残留磁束密度、 r_1 , r_2 はそれぞれPMQの内半径及び外半径である。磁石の



図2 台形8セグメントPMQ

磁束密度を高くすることで同じ磁場勾配でも内径 を大きくすることができる。磁石の材質はNd-Fe-Bで現在入手できる最も磁束密度の高い永 久磁石である住友特殊金属(株)のNEOMAX -41Hである。NEOMAX-41Hの残留磁 束密度は12.9kGが得られている。磁石は保護 のため表面にNiコーティングを行なっている。 PMQは磁石の長さ、外径、磁場勾配などの異な る6個4種類のものを製作した。

	磁石長 [mm]	内径 [mm]	磁場勾配 設計値 [kG/cm]	磁場中心の ずれx、y [mm]	角度ずれ [deg]	磁場勾配 測定値 [kG/cm]
No.1	12.0	11.6	18.0	0.044, 0.032	1.2	17.05
No.2	24.0	12.4	16.0	-0.025, 0.089	-0.6	15.71
No.3	48.0	14.6	11.7	0.037, 0.075	0.3	11.25
No.4	36.0	14.6	11.7	-0.089, 0.013	-0.5	11.06
No.5	36.0	14.6	11.7	-0.051, 0.041	-0.7	11.10
No.6	36.0	14.6	11.7	0.036, -0.039	-2.2	11.14

表1 PMQのスペック

4.磁場測定

回転コイルによる角度方向の磁場測定⁶を行なっ た。測定された磁場勾配、磁場中心のずれ、磁場 の角度方向の結果を表1に示す。設計値と比較す ると磁場勾配は2%から6%程度小さい値となっ た。反磁場の影響、磁石のバラツキ、製作誤差等 のため、設計時には式の値に0.9(経験値)をか けた値を得られる磁場勾配であるとしていたが、 それよりもやや弱い。設計値と実測値の違いを補 正するために、PMQの組み込み位置は設計通り とせずに、再びマッチング計算を行ない、その結 果からPMQの位置をずらしてマッチングがとれ るようにした。この程度の磁場中心のずれ及び角 度のずれについては、加速管の長さが短いためビ ームロスの点から言えば全く問題ないと思われる。 次にNo. 1のPMQの磁場のフーリエ成分(四 重極成分を100%とする。)を図3に示す。ダ イポール成分(n=1)及び高次成分(n \geq 3) ともにn=2の四重極成分と比較して十分小さい。



5 PMQの組み込みとトランスミッション 6個のPMQのうち2個のPMQはRFQの端 板内に設置し、バンチャーの前後にはPMQを入 れるホルダーがRFQ及びアルバレの端板に位置 の精度良く取り付けられるようになっている。図 2にBMSを横から見た断面図を示す。



図2 BMSの断面図

バンチャーの位相および電圧を最適にしたとき アルバレのトランスミッションは約90%であっ た。このときバンチャー電圧は100kV×2で あった。ほぼ良好な結果を得たが100%になら ないのは次の原因が考えられている。現状ではイ オン源からRFQへの入射でミスマッチングが起 きていることである。このためRFQから出てく るビームのエミッタンスが計算値の約2倍となっ ており、RFQのトランスミッションが80%と 低くなっている。このためBMSでもビームロス があり、ミスマッチングが起きていると考えられ る。これについては現在LEBTの改良を進めて いる。

5.おわりに

PMQを収束要素として利用することにより、 自由度の大きい、小型のBMSを製作することが できた。今後LEBT系の改良が進み10mA以 上の大電流ビームになった場合、空間電荷効果に よるミスマッチの影響がでてくる可能性がある。 ビームロスの増加があるかどうかやエミッタンス の増大について今後検証していく必要があると考 えている。

参考文献

1) H.Okamoto and Y. Iwashita; Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., Vol.64, No.1, pp20-24 (1986)

2) M.Sawamura et al.; Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., Vol.66, No.1, pp38-43 (1988)

3) H.Dewa et al.; Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., Vol.70, No.1, pp38-43 (1992)

4) H.Dewa et al.; Proceedings of the 18th Linear Accelerator Meeting in Japan pp160-164 (1993)

5) H.Dewa et al.; Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., Vol.72, No.1, pp76-86 (1994)

6) H.Okamoto et al.; Rev. Sci. Inst., Vol.60, No.9, September, pp. 2950-2980 (1989)